

Liste des tableaux

Tableau I-1 :	Bande interdite, concentration intrinsèque des porteurs, densité effective de la bande de conduction et la bande de valence à $T = 300$ K° pour différents semi-conducteurs.	14
Tableau I-2 :	Propriétés des principaux composés binaires III-V à 300 K°.	28
Tableau I-3 :	Propriétés physiques de quelques matériaux à 300 K°.	30
Tableau II-1:	Grandeurs photovoltaïques des cellules solaires à base de GaAs (a) National Renewable Energy Laboratory (USA). (b) Fraunhofer Institute for Solar Energy System (Allemagne).	45
Tableau III-1:	Groupes de commande ATLAS avec les déclarations de base dans chaque groupe	65
Tableau IV-1 :	Epaisseur et dopage des différentes couches de la cellule à hétérojonction (AlGaAs/GaAs).	71
Tableau IV-2 :	Dépendance des mobilités dans le GaAs avec la concentration du dopage.	72
Tableau IV-3:	Paramètres photovoltaïques de la cellule ($p^+ - Al_{0.491}Ga_{0.509}As$ / p- GaAs / n-GaAs).	80
Tableau IV-4 :	Paramètres photovoltaïques de la cellule ($p^+ - Al_xGa_{1-x}As$ / p- GaAs / n-GaAs) à différentes fractions molaires $x(Al)$ pour le cas sans substrat.	80
Tableau IV-5 :	Paramètres photovoltaïques de la cellule ($p^+ - Al_xGa_{1-x}As$ / p- GaAs / n-GaAs) à différentes fractions molaires $x(Al)$ pour le cas avec substrat (GaAs).	81
Tableau IV-6 :	Paramètres photovoltaïques de la cellule ($p^+ - Al_xGa_{1-x}As$ / p- GaAs / n-GaAs) pour $x(Al) = 0.85$ et $0 < x(Al) < 0.85$ sous éclaircissement AM_0	81
Tableau IV-7 :	Paramètres photovoltaïques de la cellule ($p^+ - Al_xGa_{1-x}As$ / p- GaAs / n-GaAs) où la couche fenêtre ($Al_xGa_{1-x}As$) est à fraction molaire graduelle ; $x(Al) = 0.804$ pour ($0 < x < 0.01 \mu m$), $x(Al) = 0.491$ pour ($0.01 \mu m < x < 0.02 \mu m$), $x(Al) = 0.099$ pour ($0.02 < x < 0.03 \mu m$) et comparaison avec le cas où $x(Al)$ est fixe (0.804).	84
Tableau IV-8:	Paramètres photovoltaïques de la cellule ($n^+ - Al_{0.491}Ga_{0.509}As$ / n- GaAs / p-GaAs).	87
Tableau IV-9:	Paramètres photovoltaïques de la cellule ($n^+ - Al_xGa_{1-x}As$ / n- GaAs / p-GaAs) à différentes fractions molaires $x(Al)$ pour le cas sans substrat.	87
Tableau IV-10:	Paramètres photovoltaïques de la cellule ($n^+ - Al_xGa_{1-x}As$ / n- GaAs / p-GaAs) à différentes fractions molaires $x(Al)$ pour le cas avec substrat (GaAs).	87
Tableau IV-11:	Paramètres photovoltaïques de la cellule ($n^+ - Al_xGa_{1-x}As$ / n- GaAs / p-GaAs) où la couche fenêtre ($Al_xGa_{1-x}As$) est à fraction molaire graduelle ; $x(Al) = 0.804$ pour ($0 < x < 0.01 \mu m$), $x(Al) = 0.491$ pour ($0.01 \mu m < x < 0.02 \mu m$), $x(Al) = 0.099$ pour ($0.02 < x < 0.03 \mu m$) et comparaison avec le cas où $x(Al)$ est fixe (0.491).	89

